CMST2907A

SURFACE MOUNT
PNP SILICON TRANSISTOR

SUPERmini™

SOT-323 CASE

Central Semiconductor Corp.

www.centralsemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMST2907A type is a PNP silicon transistor manufactured by the epitaxial planar process, epoxy molded in a SUPERmini™ surface mount package, designed for small signal, general purpose and switching applications.

MARKING CODE: 2FC

MAXIMUM RATINGS: (T_A=25°C)	**SYMBOL**		**UNITS**
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Continuous Collector Current	I_C	600	mA
Power Dissipation	P_D	275	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	°C
Thermal Resistance	Θ_{JA}	455	°C/W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: (T_A=25°C unless otherwise noted)

SYMBOL	**TEST CONDITIONS**	**MIN**	**MAX**	**UNITS**
I_{CBO}	V_{CB}=50V		10	nA
I_{CBO}	V_{CB}=50V, T_A=125°C		10	µA
I_{CEV}	V_{CE}=30V, V_{EB}=0.5V		50	nA
BV_{CBO}	I_C=10µA	60		V
BV_{CEO}	I_C=10mA	60		V
BV_{EBO}	I_E=10µA	5.0		V
$V_{CE(SAT)}$	I_C=150mA, I_B=15mA		0.4	V
$V_{CE(SAT)}$	I_C=500mA, I_B=50mA		1.6	V
$V_{BE(SAT)}$	I_C=150mA, I_B=15mA		1.3	V
$V_{BE(SAT)}$	I_C=500mA, I_B=50mA		2.6	V
h_{FE}	V_{CE}=10V, I_C=0.1mA	75		
h_{FE}	V_{CE}=10V, I_C=1.0mA	100		
h_{FE}	V_{CE}=10V, I_C=10mA	100		
h_{FE}	V_{CE}=10V, I_C=150mA	100	300	
h_{FE}	V_{CE}=10V, I_C=500mA	50		
f_T	V_{CE}=20V, I_C=50mA, f=100MHz	200		MHz

R4 (9-February 2010)

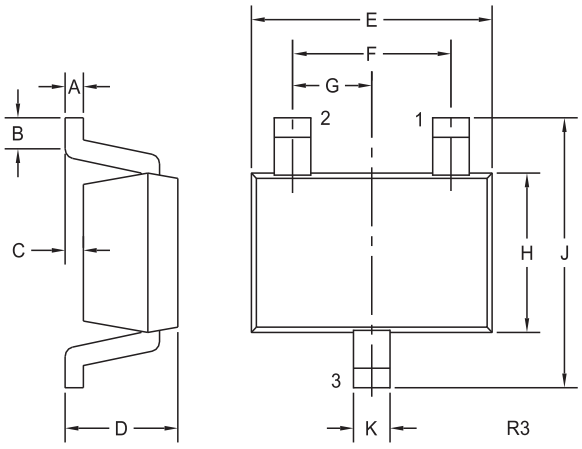
CMST2907A

SURFACE MOUNT
PNP SILICON TRANSISTOR

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - Continued: (T_A=25°C unless otherwise noted)

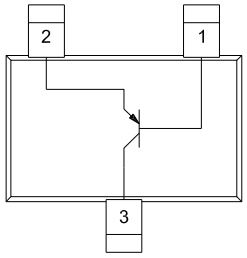
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MAX	UNITS
C_{ob}	V_{CB}=10V, I_E=0, f=1.0MHz	8.0	pF
C_{ib}	V_{EB}=2.0V, I_C=0, f=1.0MHz	30	pF
t_{on}	V_{CC}=30V, V_{BE}=0.5, I_C=150mA, I_{B1}=15mA	45	ns
t_d	V_{CC}=30V, V_{BE}=0.5, I_C=150mA, I_{B1}=15mA	10	ns
t_r	V_{CC}=30V, V_{BE}=0.5, I_C=150mA, I_{B1}=15mA	40	ns
t_{off}	V_{CC}=6.0V, I_C=150mA, I_{B1}=I_{B2}=15mA	100	ns
t_s	V_{CC}=6.0V, I_C=150mA, I_{B1}=I_{B2}=15mA	80	ns
t_f	V_{CC}=6.0V, I_C=150mA, I_{B1}=I_{B2}=15mA	30	ns

SOT-323 CASE - MECHANICAL OUTLINE



DIMENSIONS				
	INCHES		MILLIMETERS	
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.002	0.008	0.05	0.20
B	0.004	-	0.10	-
C	-	0.004	-	0.10
D	0.031	0.043	0.80	1.10
E	0.071	0.087	1.80	2.20
F	0.051		1.30	
G	0.026		0.65	
H	0.045	0.053	1.15	1.35
J	0.079	0.087	2.00	2.20
K	0.008	0.016	0.20	0.40

SOT-323 (REV: R3)



LEAD CODE:
1) Base
2) Emitter
3) Collector

MARKING CODE: 2FC

R4 (9-February 2010)

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9